

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 5月28日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-158571

出 願 人 Applicant(s):

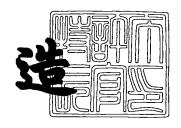
株式会社ニコン

株式会社荏原製作所

2001年 8月10日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

010298

【提出日】

平成13年 5月28日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G01B

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所

内

【氏名】

大和田 伸

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 荏原マイスター株式

会社内

【氏名】

中筋 護

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所

内

【氏名】

野路 伸治

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所

内

【氏名】

佐竹 徹

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所

内

【氏名】

曽布川 拓司

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所

内

【氏名】

西藤 睦

【特許出願人】

【識別番号】

000004112

【氏名又は名称】 株式会社ニコン

【特許出願人】

【識別番号】 000000239

【氏名又は名称】

株式会社荏原製作所

【代理人】

【識別番号】

100089705

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル2

06区 ユアサハラ法律特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】

社本 一夫

【電話番号】

03-3270-6641

【選任した代理人】

【識別番号】

100080137

【弁理士】

【氏名又は名称】 千葉 昭男

【選任した代理人】

【識別番号】

100083895

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 茂

【選任した代理人】

【識別番号】

100093713

【弁理士】

【氏名又は名称】

神田 藤博

【選任した代理人】

【識別番号】 100093805

【弁理士】

【氏名又は名称】 内田 博

【選任した代理人】

【識別番号】

100106208

【弁理士】

【氏名又は名称】

宮前 徹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

051806

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0010958

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子線による検査装置及びその検査装置を用いたデバイス製造 方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子線でパターンが形成された検査対象を照射し、前記検査 対象のパターンを検査する装置において、

電子源、対物レンズ、E×B分離器及び前記分離器で一次光学系から分離後に少なくとも1段の拡大レンズを有していて、複数の一次電子線を成形して前記検査対象に照射し、前記一次電子線の照射により放出された二次電子を前記対物レンズで加速させて前記E×B分離器で分離し、前記少なくとも1段の拡大レンズで二次電子像を投影する電子光学系と、

前記電子光学系により投影された二次電子像を検出する複数の検出器と、

前記検査対象を保持して前記電子光学系に関して相対的に移動させるステージ 装置と、

前記ステージ装置を収容しておりかつ真空雰囲気に制御可能になっているワー キングチャンバと、

前記ワーキングチャンバ内の前記ステージ装置上に検査対象を供給するローダーと、

前記ワーキングチャンバ内に配置された、前記検査対象に電位を印加する電位 印加機構と、

前記電子光学系に対する前記検査対象の位置決めのために前記検査対象の表面 を観察してアライメントを制御するアライメント制御装置とを備え、

前記真空チャンバは床からの振動を遮断する振動遮断装置を介して支持されていることを特徴とする電子線による検査装置。

【請求項2】 請求項1に記載の検査装置において、前記ローダーが、それぞれが独立して雰囲気制御可能になっている第1のローディングチャンバ及び第2のローディングチャンバと、前記検査対象を第1のローディングチャンバ内とその外部との間で搬送する第1の搬送ユニットと、前記第2のローディングチャンバ内と前記がいた。

ステージ装置上との間で搬送する第2の搬送ユニットとを備え、前記検査装置が 、前記ローダーに検査対象を供給するための仕切られたミニエンバイロメント空間を更に備えることを特徴とする検査装置。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の検査装置において、前記ステージ装置上の前記検査対象の座標を検出するレーザ干渉測距装置を備え、前記アライメント制御装置により、検査対象に存在するパターンを利用して検査対象の座標を決めることを特徴とする検査装置。

【請求項4】 請求項2又は3に記載の検査装置において、前記検査対象の位置合わせは、前記ミニエンバイロメント空間内で行われる粗位置合わせと、前記ステージ装置上で行われるXY方向の位置合わせ及び回転方向の位置合わせとを含むことを特徴とする検査装置。

【請求項5】 請求項1ないし4に記載の検査装置を用いてプロセス途中又はその後のウエハの欠陥を検出するデバイス製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本発明は、複数の電子ビームを用いて検査対象の表面に形成されたパターンの 欠陥等を検査する検査装置に関し、詳しくは、半導体製造工程におけるウエハの 欠陥を検出する場合のように、電子ビームを検査対象に照射してその表面の性状 に応じて変化する二次電子を捕捉して画像データを形成し、その画像データに基 づいて検査対象の表面に形成されたパターン等を高いスループットで検査する検 査装置、並びにそのような検査装置を用いて歩留まり良くデバイスを製造するデ バイス製造方法に関する。

[0002]

【従来技術】

本発明に関連する検査装置の従来技術については、走査電子顕微鏡(SEM)を用いた装置が既に市販されている。この装置は細く絞った電子線を非常に間隔の小さいラスタ幅でラスタ走査を行い、走査に伴って検査対象から放出される二次電子を二次電子検出器で検出してSEM画像を形成し、そのSEM画像を異な

るダイの同じ場所同志を比較して欠陥を抽出するものである。

また、複数の電子線すなわちマルチビームを用いてスループットを向上するという提案は多く成されているが、開示されているものは、如何にしてマルチビームをつくるかと言うことと、如何にしてマルチビームを検出するかと言うことについてであり、欠陥検査装置全体をシステムとして完成させた装置は未だ存在しなかった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、SEMを応用した欠陥検査装置では、ビーム寸法が小さく、当然画素寸法が小さく、ラスタ幅も小さいため、欠陥検査に多くの時間を必要としていた。また、高スループットにするため、ビーム電流を大きくすると絶縁物が表面にあるウエハでは帯電して良好なSEM像が得られない問題があった。

また、マルチビームを用いた装置では電子光学系のみでなく、装置の全体構成が不明であり、電子光学系と他のサブシステムとの間の相互作用等については今までほとんど明らかにされていなかった。更に、検査対象となるウエハの大径化が進められ、サブシステムもそれに対応可能にする要請もでてきた。

[0004]

本発明は上記の問題点に鑑みなされたものであって、発明が解決しようとする一つの課題は、マルチビームを用いた電子光学系を使用すると共に、その電子光学系と、検査装置を構成するその他の構成機器との調和を図ってスループットを向上した検査装置を提供することである。

本発明が解決しようとする他の課題は、SEMで問題のあった帯電の問題を解 決して検査対象を精度良く検査可能な検査装置を提供することである。

本発明が解決しようとする更に別の課題は、上記のような検査装置を用いてウエハ等の検査対象の検査を行うことにより歩留まりの良いデバイス製造方法を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本願の発明は、電子線でパターンが形成された検査対象を照射し、前記検査対

象のパターンを検査する装置において、

電子源、対物レンズ、E×B分離器及び前記分離器で一次光学系から分離後少なくとも1段の拡大レンズを有していて、複数の一次電子線を成形して前記検査対象に照射し、前記一次電子線の照射により放出された二次電子を前記対物レンズで加速させて前記E×B分離器で分離し、前記少なくとも1段の拡大レンズで二次電子像を投影する電子光学系と、

前記電子光学系により投影された二次電子像を検出する複数の検出器と、

前記検査対象を保持して前記電子光学系に関して相対的に移動させるステージ 装置と、

前記ステージ装置を収容しておりかつ真空雰囲気に制御可能になっているワーキングチャンバと、

前記ワーキングチャンバ内の前記ステージ装置上に検査対象を供給するローダーと、

前記ワーキングチャンバ内に配置された、前記検査対象に電位を印加する電位 印加機構と、

前記電子光学系に対する前記検査対象の位置決めのために前記検査対象の表面 を観察してアライメントを制御するアライメント制御装置とを備え、

前記真空チャンバは床からの振動を遮断する振動遮断装置を介して支持され て構成されている。

[0006]

上記検査装置において、前記ローダーが、それぞれが独立して雰囲気制御可能になっている第1のローディングチャンバ及び第2のローディングチャンバと、前記検査対象を第1のローディングチャンバ内とその外部との間で搬送する第1の搬送ユニットと、前記第2のローディングチャンバに設けられていて前記検査対象を前記第1のローディングチャンバ内と前記ステージ装置上との間で搬送する第2の搬送ユニットとを備え、前記検査装置が、前記ローダーに検査対象を供給するための仕切られたミニエンバイロメント空間を更に備えていてもよい。

また、前記ステージ装置上の前記検査対象の座標を検出するレーザ干渉測距装置を備え、前記アライメント制御装置により検査対象に存在するパターンを利用

して検査対象の座標を決めしてもよく、この場合、前記検査対象の位置合わせは、前記ミニエンバイロメント空間内で行われる粗位置合わせと、前記ステージ装置上で行われるXY方向の位置合わせ及び回転方向の位置合わせとを含んでいてもよい。

本願の他の発明は、検査装置を用いてプロセス途中又はその後のウエハの欠陥を検出するデバイス製造方法である。

[0007]

【実施の形態】

以下、図面を参照して、本発明一つの実施形態について、検査対象として表面 にパターンが形成された基板すなわちウエハを検査する半導体検査装置として説 明する。

図1及び図2において、本実施形態の半導体検査装置1の主要構成要素が立面 及び平面で示されている。

本実施形態の半導体検査装置1は、複数枚のウエハを収納したカセットを保持するカセットホルダ10と、ミニエンバイロメント装置20と、ワーキングチャンバを画成する主ハウジング30と、ミニエンバイロメント装置20と主ハウジング30との間に配置されていて、二つのローディングチャンバを画成するローダハウジング40と、ウエハをカセットホルダ10から主ハウジング30内に配置されたステージ装置50上に装填するローダー60と、真空ハウジングに取り付けられた電子光学装置70と、を備え、それらは図1及び図2に示されるような位置関係で配置されている。半導体検査装置1は、更に、真空の主ハウジング30内に配置されたプレチャージユニット81と、ウエハに電位を印加する電位印加機構83(図8に図示)と、電子ビームキャリブレーション機構85(図10に図示)と、ステージ装置上でのウエハの位置決めを行うためのアライメント制御装置87を構成する光学顕微鏡871とを備えている。

[0008]

カセットホルダ10は、複数枚(例えば25枚)のウエハが上下方向に平行に 並べられた状態で収納されたカセットc(例えば、アシスト社製のFOUPのよ うなクローズドカセット)を複数個(この実施形態では2個)保持するようにな

っている。このカセットホルダとしては、カセットをロボット等により搬送してきて自動的にカセットホルダ10に装填する場合にはそれに適した構造のものを、また人手により装填する場合にはそれに適したオープンカセット構造のものをそれぞれ任意に選択して設置できるようになっている。カセットホルダ10は、この実施形態では、自動的にカセットcが装填される形式であり、例えば昇降テーブル11と、その昇降テール11を上下移動させる昇降機構12とを備え、カセットcは昇降テーブル上に図2で鎖線図示の状態で自動的にセット可能になっていて、セット後、図2で実線図示の状態に自動的に回転されてミニエンバイロメント装置内の第1の搬送ユニットの回動軸線に向けられる。また、昇降テーブル11は図1で鎖線図示の状態に降下される。このように、自動的に装填する場合に使用するカセットホルダ、或いは人手により装填する場合に使用するカセットホルダはいずれも公知の構造のものを適宜使用すれば良いので、その構造及び機能の詳細な説明は省略する。

なお、カセット c 内に収納される基板すなわちウエハは、検査を受けるウエハであり、そのような検査は、半導体製造工程中でウエハを処理するプロセスの後、若しくはプロセスの途中で行われる。具体的には、成膜工程、CMP、イオン注入等を受けた基板すなわちウエハ、表面に配線パターンが形成されたウエハ、又は配線パターンが未だに形成されていないウエハが、カセット内に収納される。カセット c 内に収容されるウエハは多数枚上下方向に隔ててかつ平行に並べて配置されているため、任意の位置のウエハと後述する第1の搬送ユニットで保持できるように、第1の搬送ユニットのアームを上下移動できるようになっている

[0009]

図1ないし図3において、ミニエンバイロメント装置20は、雰囲気制御されるようになっているミニエンバイロメント空間21を画成するハウジング22と、ミニエンバイロメント空間21内で清浄空気のような気体を循環して雰囲気制御するための気体循環装置23と、ミニエンバイロメント空間21内に供給された空気の一部を回収して排出する排出装置24と、ミニエンバイロメント空間21内に配設されていて検査対象としての基板すなわちウエハを粗位置決めするプ

リアライナー25とを備えている。

ハウジング22は、頂壁221、底壁222及び四周を囲む周壁223を有し ていてい、ミニエンバイロメント空間21を外部から遮断する構造になっている 。ミニエンバイロメント空間を雰囲気制御するために、気体循環装置23は、図 3に示されるように、ミニエンバイロメント空間21内において、頂壁221に 取り付けられていて、気体(この実施形態では空気)を清浄にして一つ又はそれ 以上の気体吹き出し口(図示せず)を通して清浄空気を真下に向かって層流状に 流す気体供給ユニット231と、ミニエンバイロメント空間内において底壁22 2の上に配置されていて、底に向かって流れ下った空気を回収する回収ダクト2 32と、回収ダクト232と気体供給ユニット231とを接続して回収された空 気を気体供給ユニット231に戻す導管233とを備えている。この実施形態で は、気体供給ユニット231は供給する空気の約20%をハウジング22の外部 から取り入れて清浄にするようになっているが、この外部から取り入れられる気 体の割合は任意に選択可能である。気体供給ユニット231は、清浄空気をつく りだすための公知の構造のHEPA若しくはULPAフィルタを備えている。清 浄空気の層流状の下方向の流れすなわちダウンフローは、主に、ミニエンバイロ メント空間21内に配置された後述する第1の搬送ユニットによる搬送面を通し て流れるように供給され、搬送ユニットにより発生する虞のある塵埃がウエハに 付着するのを防止するようになっている。したがって、ダウンフローの噴出口は 必ずしも図示のように頂壁に近い位置である必要はなく、搬送ユニットによる搬 送面より上側にあればよい。また、ミニエンバイロメント空間全面に亘って流す 必要もない。なお、場合によっては、清浄空気としてイオン風を使用することに よって清浄度を確保することができる。また、ミニエンバイロメント空間内には 清浄度を観察するためのセンサを設け、清浄度が悪化したときに装置をシャット ダウンすることもできる。ハウジング22の周壁223のうちカセットホルダ1 0に隣接する部分には出入り口225が形成されている。出入り口225近傍に は公知の構造のシャッタ装置を設けて出入り口225をミニエンバイロメント装 置側から閉じるようにしてもよい。ウエハ近傍でつくる層流のダウンフローは、 例えば0.3ないし0.4m/secの流速でよい。気体供給ユニットはミニエ

ンバイロメント空間内でなくその外側に設けてもよい。

[0010]

排出装置24は、前記搬送ユニットのウエハ搬送面より下側の位置で搬送ユニットの下部に配置された吸入ダクト241と、ハウジング22の外側に配置されたブロワー242と、吸入ダクト241とブロワー242とを接続する導管243と、を備えている。この排出装置24は、搬送ユニットの周囲を流れ下り搬送ユニットにより発生する可能性のある塵埃を含んだ気体を、吸入ダクト241により吸引し、導管243、244及びブロワー242を介してハウジング22の外側に排出する。この場合、ハウジング22の近くに引かれた排気管(図示せず)内に排出してもよい。

ミニエンバイロメント空間21内に配置されたアライナー25は、ウエハに形成されたオリエンテーションフラット(円形のウエハの外周に形成された平坦部分を言い、以下においてオリフラと呼ぶ)や、ウエハの外周縁に形成された一つ又はそれ以上のV型の切欠きすなわちノッチを光学的に或いは機械的に検出してウエハの軸線O-Oの周りの回転方向の位置を約±1度の精度で予め位置決めしておくようになっている。プリアライナーは請求項に記載された発明の検査対象の座標を決める機構の一部を構成し、検査対象の粗位置決めを担当する。このプリアライナー自体は公知の構造のものでよいので、その構造、動作の説明は省略する。

なお、図示しないが、プリアライナーの下部にも排出装置用の回収ダクトを設けて、プリアライナーから排出された塵埃を含んだ空気を外部に排出するようにしてもよい。

[0011]

図1及び図2において、ワーキングチャンバ31を画成する主ハウジング30は、ハウジング本体32を備え、そのハウジング本体32は、台フレーム36上に配置された振動遮断装置すなわち防振装置37の上に載せられたハウジング支持装置33によって支持されている。ハウジング支持装置33は矩形に組まれたフレーム構造体331を備えている。ハウジング本体32はフレーム構造体331上に配設固定されていて、フレーム構造体上に載せられた底壁321と、頂壁

322と、底壁321及び頂壁322に接続されて四周を囲む周壁323とを備えていてワーキングチャンバ31を外部から隔離している。底壁321は、この実施形態では、上に載置されるステージ装置等の機器による加重で歪みの発生しないように比較的肉厚の厚い鋼板で構成されているが、その他の構造にしてもよい。この実施形態において、ハウジング本体及びハウジング支持装置33は、剛構造に組み立てられていて、台フレーム36が設置されている床からの振動がこの剛構造に伝達されるのを防振装置37で阻止するようになっている。ハウジング本体32の周壁323のうち後述するローダハウジングに隣接する周壁にはウエハ出し入れ用の出入り口325が形成されている。

なお、防振装置は、空気バネ、磁気軸受け等を有するアクティブ式のものでも、或いはこれらを有するパッシブ式のもよい。いずれも公知の構造のものでよいので、それ自体の構造及び機能の説明は省略する。ワーキングチャンバ31は公知の構造の真空装置(図示せず)により真空雰囲気に保たれるようになっている。台フレーム36の下には装置全体の動作を制御する制御装置2が配置されている。

[0012]

図1、図2及び図4において、ローダハウジング40は、第1のローディングチャンバ41と第2のローディングチャンバ42とを画成するハウジング本体43は底壁431と、頂壁432と、四周を囲む周壁433と、第1のローディングチャンバ41と第2のローディングチャンバ41と第2のローディングチャンバ42とを仕切る仕切壁434とを有していて、両ローディングチャンバを外部から隔離できるようになっている。仕切壁434には両ローディングチャンバ間でウエハのやり取りを行うための開口すなわち出入り口435が形成されている。また、周壁433のミニエンバイロメント装置及び主ハウジングに隣接した部分には出入り口436及び437が形成されている。このローダハウジング40のハウジング本体43は、ハウジング支持装置33のフレーム構造体331上に載置されてそれによって支持されている。したがって、このローダハウジング40の出入り口436とミニエンバイロメント装置のハウジング22の出入り口226とは

整合されていて、そこにはミニエンバイロメント空間21と第1のローディング チャンバ41との連通を選択的に阻止するシャッタ装置27が設けられている。 シャッタ装置27は、出入り口226及び436の周囲を囲んで側壁433と密 に接触して固定されたシール材271、シール材271と協働して出入り口を介 しての空気の流通を阻止する扉272と、その扉を動かす駆動装置273とを有 している。また、ローダハウジング40の出入り口437とハウジング本体32 の出入り口325とは整合されていて、そこには第2のローディングチャンバ4 2とワーキンググチャンバ31との連通を選択的に密封阻止するシャッタ装置4 5が設けられている。シャッタ装置45は、出入り口437及び325の周囲を 囲んで側壁433及び323と密に接触してそれらに固定されたシール材451 、シール材451と協働して出入り口を介しての空気の流通を阻止する扉452 と、その扉を動かす駆動装置453とを有している。更に、仕切壁434に形成 された開口には、扉461によりそれを閉じて第1及び第2のローディングチャ ンバ間の連通を選択的に密封阻止するシャッタ装置46が設けられている。これ らのシャッタ装置27、45及び46は、閉じ状態にあるとき各チャンバを気密 シールできるようになっている。これらのシャッタ装置は公知のものでよいので 、その構造及び動作の詳細な説明は省略する。なお、ミニエンバイロメント装置 20のハウジング22の支持方法とローダハウジングの支持方法が異なり、ミニ エンバイロメント装置を介して床からの振動がローダハウジング40、主ハウジ ング30に伝達されるのを防止するために、ハウジング22とローダハウジング 40との間には出入り口の周囲を気密に囲むように防振用のクッション材を配置 しておけば良い。

[0013]

第1のローディングチャンバ41内には、複数(この実施形態では2枚)のウエハを上下に隔てて水平の状態で支持するウエハラック47が配設されている。ウエハラック47は、図5の示されるように、矩形の基板471の四隅に互いに隔てて直立状態で固定された支柱472を備え、各支柱472にはそれぞれ2段の支持部473及び474が形成され、その支持部の上にウエハWの周縁を載せて保持するようになっている。そして後述する第1及び第2の搬送ユニットのア

ームの先端を隣接する支柱間からウエハに接近させてアームによりウエハを把持 するようになっている。

[0014]

ローディングチャンバ41及び42は、図示しない真空ポンプを含む公知の構造の真空排気装置(図示せず)によって高真空状態(真空度としては10⁻⁵~10⁻⁶Pa)に雰囲気制御され得るようになっている。この場合、第1のローディングチャンバ41を低真空チャンバとして低真空雰囲気に保ち、第2のローディングチャンバ42を高真空チャンバとして高真空雰囲気に保ち、ウエハの汚染防止を効果的に行うこともできる。このような構造を採用することによってローディングチャンバ内に収容されていて次に欠陥検査されるウエハをワーキングチャンバ内に遅滞なく搬送することができる。このようなローディングチャンバを採用することによって、後述するマルチビーム型電子装置原理と共に、欠陥検査のスループットを向上させ、更に保管状態が高真空状態であることを要求される電子源周辺の真空度を可能な限り高真空度状態にすることができる。

第1及び第2のローディングチャンバ41及び42は、それぞれ真空排気配管と不活性ガス(例えば乾燥純窒素)用のベント配管(それぞれ図示せず)が接続されている。これによって、各ローディングチャンバ内の大気圧状態は不活性ガスベント(不活性ガスを注入して不活性ガス以外の酸素ガス等が表面に付着するのを防止する)によって達成される。このような不活性ガスベントを行う装置自体は公知の構造のものでよいので、その詳細な説明は省略する。

なお、電子線を使用する本発明の検査装置において、後述する電子光学系の電子源として使用される代表的な六硼化ランタン(LaB₆)等は一度熱電子を放出する程度まで高温状態に加熱された場合には、酸素等に可能な限り接触させないことがその寿命を縮めないために肝要であるが、電子光学系が配置されているワーキングチャンバにウエハを搬入する前段階で上記のような雰囲気制御を行うことにより、より確実に実行できる。

[0015]

ステージ装置50は、主ハウジング30の底壁321上に配置された固定テーブル51と、固定テーブル上でY方向(図1において紙面に垂直の方向)に移動

するYテーブル52と、Yテーブル上でX方向(図1において左右方向)に移動 するXテーブル53と、Xテーブル上で回転可能な回転テーブル54と、回転テ ーブル54上に配置されたホルダ55とを備えている。そのホルダ55のウエハ 載置面551上にウエハを解放可能に保持する。ホルダは、ウエハを機械的に或 いは静電チャック方式で解放可能に把持できる公知の構造のものでよい。ステー ジ装置50は、サーボモータ、エンコーダ及び各種のセンサ(図示せず)を用い て、上記のような複数のテーブルを動作させることにより、載置面551上でホ ルダに保持されたウエハを電子光学装置から照射される電子ビームに対してX方 向、Y方向及びZ方向(図1において上下方向)に、更にウエハの支持面に鉛直 な軸線の回り方向 (θ 方向) に高い精度で位置決めできるようになっている。な お、乙方向の位置決めは、例えばホルダ上の載置面の位置を乙方向に微調整可能 にしておけばよい。この場合、載置面の基準位置を微細径レーザによる位置測定 装置(干渉計の原理を使用したレーザ干渉測距装置)によって検知し、その位置 を図示しないフィードバック回路によって制御したり、それと共に或いはそれに 代えてウエハのノッチ或いはオリフラの位置を測定してウエハの電子ビームに対 する平面位置、回転位置を検知し、回転テーブルを微小角度制御可能なステッピ ングモータなどにより回転させて制御する。ワーキングチャンバ内での塵埃の発 生を極力防止するために、ステージ装置用のサーボモータ521、531及びエ ンコーダ522、532は、主ハウジング30の外側に配置されている。なお、 ステージ装置50は、例えばステッパー等で使用されている公知の構造のもので 良いので、その構造及び動作の詳細な説明は省略する。また、上記レーザ干渉測 距装置も公知の構造のものでよいので、その構造、動作の詳細な説明は省略する

[0016]

電子ビームに対するウエハの回転位置や、X、Y位置を予め後述する信号検出 系或いは画像処理系に入力することで得られる信号の基準化を図ることもできる 。更に、このホルダに設けられたウエハチャック機構は、ウエハをチャックする ための電圧を静電チャックの電極に与えられるようになっていて、ウエハの外周 部の3点(好ましくは周方向に等隔に隔てられた)を押さえて位置決めするよう

になっている。ウエハチャック機構は、二つの固定位置決めピンと、一つの押圧 式クランクピンとを備えている。クランプピンは、自動チャック及び自動リリー スを実現できるようになっており、かつ電圧印加の導通箇所を構成している。

なお、この実施形態では図2で左右方向に移動するテーブルをXテーブルとし、上下方向に移動するテーブルをYテーブルとしたが、同図で左右方向に移動するテーブルをYテーブルとし、上下方向に移動するテーブルをXテーブルとしてもよい。

[0017]

ローダー60は、ミニエンバイロメント装置20のハウジング22内に配置されたロボット式の第1の搬送ユニット61と、第2のローディングチャンバ42 内に配置されたロボット式の第2の搬送ユニット63とを備えている。

第1の搬送ユニット61は、駆動部611に関して軸線 O_1 - O_1 の回りで回転可能になっている多節のアーム612を有している。多節のアームとしては任意の構造のものを使用できるが、この実施形態では、互いに回動可能に取り付けられた三つの部分を有している。第1の搬送ユニット61のアーム612の一つの部分すなわち最も駆動部611側の第1の部分は、駆動部611内に設けられた公知の構造の駆動機構(図示せず)により回転可能な軸613に取り付けられている。アーム612は、軸613により軸線 O_1 - O_1 の回りで回動できると共に、部分間の相対回転により全体として軸線 O_1 - O_1 に関して半径方向に伸縮可能になっている。アーム612の軸613から最も離れた第3の部分の先端には、には公知の構造の機械式チャック又は静電チャック等のウエハを把持する把持装置616が設けられている。駆動部611は、公知の構造の昇降機構615により上下方向に移動可能になっている。

この第1の搬送ユニット61は、アーム612がカセットホルダに保持された 二つのカセット c の内いずれか一方の方向M1又はM2に向かってアームが伸び 、カセット c 内に収容されたウエハを1枚アームの上に載せ或いはアームの先端 に取り付けたチャック(図示せず)により把持して取り出す。その後アームが縮 み(図2に示すような状態)、アームがプリアライナー25の方向M3に向かっ て伸長できる位置まで回転してその位置で停止する。するとアームが再び伸びて

アームに保持されたウエハをプリアライナー25に載せる。プリアライナーから前記と逆にしてウエハを受け取った後はアームは更に回転し第2のローディングチャンバ41に向かって伸長できる位置(向きM4)で停止し、第2のローディングチャンバ41内のウエハ受け47にウエハを受け渡す。なお、機械的にウエハを把持する場合にはウエハの周縁部(周縁から約5mmの範囲)を把持する。これはウエハには周縁部を除いて全面にデバイス(回路配線)が形成されており、この部分を把持するとデバイスの破壊、欠陥の発生を生じさせるからである。

[0018]

第2の搬送ユニット63も第1の搬送ユニットと構造が基本的に同じであり、 ウエハの搬送をウエハラック47とステージ装置の載置面上との間で行う点での み相違するだけであるから、詳細な説明は省略する。

上記ローダー60では、第1及び第2の搬送ユニット61及び63は、カセットホルダに保持されたカセットからワーキングチャンバ31内に配置されたステージ装置50上への及びその逆のウエハの搬送をほぼ水平状態に保ったままで行い、搬送ユニットのアームが上下動するのは、単に、ウエハのカセットからの取り出し及びそれへの挿入、ウエハのウエハラックへの載置及びそこからの取り出し及びウエハのステージ装置への載置及びそこからの取り出しのときるだけである。したがって、大型のウエハ、例えば直径30cmのウエハの移動もスムースに行うことができる。

[0019]

次にカセットホルダに支持されたカセットcからワーキングチャンバ31内に配置されたステージ装置50までへのウエハの搬送を順を追って説明する。

カセットホルダ10は、前述のように人手によりカセットをセットする場合にはそれに適した構造のものが、また自動的にカセットをセットする場合にはそれに適した構造のものが使用される。この実施形態において、カセット c がカセットホルダ10の昇降テーブル11の上にセットされると、昇降テーブル11は昇降機構12によって降下されカセット c が出入り口225に整合される。

カセットが出入り口225に整合されると、カセットに設けられたカバー (図示せず)が開きまたカセットcとミニエンバイロメントの出入り口225との間

には筒状の覆いが配置されてカセット内及びミニエンバイロメント空間内を外部から遮断する。これらの構造は公知のものであるから、その構造及び動作の詳細な説明は省略する。なお、ミニエンバイロメント装置20側に出入り口225を開閉するシャッタ装置が設けられている場合にはそのシャッタ装置が動作して出入り口225を開く。

一方第1の搬送ユニット61のアーム612は方向M1又はM2のいずれかに向いた状態(この説明ではM1の方向)で停止しており、出入り口225が開くとアームが伸びて先端でカセット内に収容されているウエハのうち1枚を受け取る。なお、アームと、カセットから取り出されるべきウエハとの上下方向の位置調整は、この実施形態では第1の搬送ユニット61の駆動部611及びアーム612の上下移動で行うが、カセットホルダの昇降テーブルの上下動行っても或いはその両者で行ってもよい。

[0020]

アーム612によるウエハの受け取りが完了すると、アームは縮み、シャッタ装置を動作して出入り口を閉じ(シャッタ装置がある場合)、次にアーム612は軸線〇1-〇1の回りで回動して方向M3に向けて伸長できる状態になる。すると、アームは伸びて先端に載せられ或いはチャックで把持されたウエハをプリアライナー25の上に載せ、そのプリアライナーによってウエハの回転方向の向き(ウエハ平面に垂直な中心軸線の回りの向き)を所定の範囲内に位置決めする。位置決めが完了すると搬送ユニット61はアームの先端にプリアライナー25からウエハを受け取ったのちアームを縮ませ、方向M4に向けてアームを伸長できる姿勢になる。するとシャッタ装置27の扉272が動いて出入り口226及び436を開き、アーム612が伸びてウエハを第1のローディングチャンバ41内のウエハラック47の上段側又は下段側に載せる。なお、前記のようにシャッタ装置27が開いてウエハラック47にウエハが受け渡される前に、仕切壁434に形成された開口435はシャッタ装置46の扉461により気密状態で閉じられている。

[0021]

上記第1の搬送ユニットによるウエハの搬送過程において、ミニエンバイロメ

ント装置のハウジングの上に設けられた気体供給ユニット231からは清浄空気が層流状に流れ(ダウンフローとして)、搬送途中で塵埃がウエハの上面に付着するのを防止する。搬送ユニット周辺の空気の一部(この実施形態では供給ユニットから供給される空気の約20%で主に汚れた空気)は排出装置24の吸入ダクト241から吸引されてハウジング外に排出される。残りの空気はハウジングの底部に設けられた回収ダクト232を介して回収され再び気体供給ユニット231に戻される。

[0022]

ローダハウジング40の第1のローディングチャンバ41内のウエハラック4 7内に第1の搬送ユニット61によりウエハが載せられると、シャッタ装置27 が閉じて、ローディングチャンバ41内を密閉する。すると、第1のローディン グチャンバ41内には不活性ガスが充填されて空気が追い出された後、その不活 性ガスも排出されてそのローディングチャンバ41内は真空雰囲気にされる。こ の第1のローディングチャンバの真空雰囲気は低真空度でよい。ローディングチ ャンバ41内の真空度がある程度得られると、シャッタ装置46が動作して扉4 61で密閉していた出入り口434を開き、第2の搬送ユニット63のアーム6 32が伸びて先端の把持装置でウエハ受け47から1枚のウエハを受け取る(先 端の上に載せて或いは先端に取り付けられたチャックで把持して)。ウエハの受 け取りが完了するとアームが縮み、シャッタ装置46が再び動作して扉461で 出入り口435を閉じる。なお、シャッタ装置46が開く前にアーム632は予 めウエハラック47の方向N1に向けて伸長できる姿勢になる。また、前記のよ うにシャッタ装置46が開く前にシャッタ装置45の扉452で出入り口437 、325を閉じていて、第2のローディングチャンバ42内とワーキングチャン バ31内との連通を気密状態で阻止しており、第2のローディングチャンバ42 内は真空排気される。

[0023]

シャッタ装置46が出入り口435を閉じると、第2のローディングチャンバ内は再度真空排気され、第1のローディングチャンバ内よりも高真空度で真空にされる。その間に、第2の搬送ユニット61のアームはワーキングチャンバ31

内のステージ装置 5 0 の方向に向いて伸長できる位置に回転される。一方ワーキングチャンバ3 1 内のステージ装置では、Yテーブル5 2 が、Xテーブル5 3 の中心線 X₀ - X₀が第 2 の搬送ユニット 6 3 の回動軸線 O₂ - O₂を通る X 軸線 X₁ - X₁とほぼ一致する位置まで、図 2 で上方に移動し、また、Xテーブル5 3 は図 2 で最も左側の位置に接近する位置まで移動し、この状態で待機している。第 2 のローディングチャンバがワーキングチャンバの真空状態と略同じになると、シャッタ装置 4 5 の扉 4 5 2 が動いて出入り口 4 3 7、3 2 5 を開き、アームが伸びてウエハを保持したアームの先端がワーキングチャンバ3 1 内のステージ装置に接近する。そしてステージ装置 5 0 の載置面 5 5 1 上にウエハを載置する。ウエハの載置が完了するとアームが縮み、シャッタ装置 4 5 が出入り口 4 3 7、3 2 5 を閉じる。

以上は、カセット c内のウエハをステージ装置上に搬送するまでの動作に付いて説明したが、ステージ装置に載せられて処理が完了したウエハをステージ装置からカセット c内に戻すには前述と逆の動作を行って戻す。また、ウエハラック47に複数のウエハを載置しておくため、第2の搬送ユニットでウエハラックとステージ装置との間でウエハの搬送を行う間に、第1の搬送ユニットでカセットとウエハラックとの間でウエハの搬送を行うことができ、検査処理を効率良く行うことができる。

[0024]

図6において、主ハウジングの支持方法の変形例がで示されている。図6 [A] に示された変形例では、ハウジング支持装置33aを厚肉で矩形の鋼板331aで構成し、その鋼板の上にハウジング本体32aが載せられている。したがって、ハウジング本体32aの底壁321aは、前記実施形態の底壁に比較して薄い構造になっている。図6 [B] に示された変形例では、ハウジング支持装置33bのフレーム構造体336bによりハウジング本体32b及びローダハウジング40bを吊り下げて状態で支持するようになっている。フレーム構造体336bに固定された複数の縦フレーム337bの下端は、ハウジング本体32bの底壁321bの四隅に固定され、その底壁により周壁及び頂壁を支持するようになっている。そして防振装置37bは、フレーム構造体336bと台フレーム36

bとの間に配置されている。また、ローダハウジング40もフレーム構造体336に固定された吊り下げ部材49bによって吊り下げられている。ハウジング本体32bのこの図6[B]に示された変形例では、吊り下げ式に支えるので主ハウジング及びその中に設けられた各種機器全体の低重心化が可能である。上記変形例を含めた主ハウジング及びローダハウジングの支持方法では主ハウジング及びローダハウジングに床からの振動が伝わらないようになっている。

図示しない別の変形例では、主ハウジングのハウジング本外のみがハウジング 支持装置によって下から支えられ、ローダハウジングは隣接するミニエンバイロ メント装置と同じ方法で床上に配置され得る。また、図示しない更に別の変形例 では、主ハウジングのハウジング本体のみがフレーム構造体に吊り下げ式で支持 され、ローダハウジングは隣接するミニエンバイロメント装置と同じ方法で床上 に配置され得る。

[0025]

電子光学装置70は、ハウジング本体32に固定された鏡筒71を備え、その中には、図7及び図8に概略図示するような、一次電子光学系(以下単に一次光学系)74とを備える電子光学系と、検出系76とが設けられている。一次光学系72は、電子線を検査対象であるウエハWの表面に照射する光学系で、電子線を放出する電子銃721と、電子銃721から放出された一次電子線を集束する静電レンズすなわちコンデンサレンズ722と、コンデンサレンズ722の下方に配置されかつ複数の開口が形成されていて一次電子線を複数の一次電子ビームすなわちマルチビームに形成するマルチ開口板723と、一次電子ビームを縮小する静電レンズである縮小レンズ724と、ウイーンフィルタすなわちE×B分離器725と、対物レンズ726と、を備え、それらは、図7に示されるように電子銃721を最上部にして順に、しかも電子銃から放出される一次電子線の光軸が検査対象Sの表面に鉛直になるように配置されている。

縮小レンズ724及び対物レンズ726の像面湾曲収差の影響をなくすため、 マルチ開口板723に形成される複数(この実施形態では9個)の開口723a は、図8に示されるように光軸を中心とした円の円周上に形成され、しかもその

開口のX軸上への投影像のX方向の間隔Lxが同じになるように配置されている

[0026]

二次光学系74は、E×B型偏向器724により一次光学系から分離された二次電子を通す2段の静電レンズである拡大レンズ741及び742と、マルチ開口検出板743を備えている。マルチ開口検出板743に形成される開口743 aは、一次光学系のマルチ開口板723に形成されている開口723aと一対一で対応するようになっている。

[0027]

検出系76は、二次光学系74のマルチ開口検出板743の各開口743aに対応してそれに近接して配置された複数(この実施形態では9個)検出器761 と、各検出器761にA/D変換器762を介して電気的に接続された画像処理部763とを備えている。

[0028]

次に、上記構成の電子光学装置70の動作に付いて説明する。

電子銃721から放出された一次電子線は、一次光学系72のコンデンサレンズ722によって集束されて点P1においてクロスオーバを形成する。一方、コンデンサレンズ722によって集束された一次電子線は、マルチ開口板の複数の開口723aを通して複数の一次電子ビームが形成され、縮小レンズ724によって縮小されて位置P2に投影される。位置P2で合焦した後、更に対物レンズ726によってウェハWの表面上に合焦される。一方、一次電子線ビームは縮小レンズ724と対物レンズ726との間に配置された偏向器727によってウェハWの表面上を走査するように偏向される。

合焦された複数(この実施形態では9本)の一次電子ビームによって試料Sは複数の点が照射され、照射されたこれらの複数の点からは二次電子が放出される。この二次電子は、対物レンズ726の電界に引かれて細く集束され、E×B分離器725で偏向されて二次光学系74に投入される。二次電子による像は偏向器725に関して位置P2より近い位置P3において焦点を結ぶ。これは、一次電子ビームがウエハ面上で500eVのエネルギを有しているのに対して、二次

電子が数evのエネルギしか有していないためである。

[0029]

位置P3で合焦された二次電子の像は2段の拡大レンズ741、742でマルチ開口検出板743の対応する開口743aに合焦され、その像を各開口743aに対応して配置された検出器761で検出する。検出器761は、検出した電子線を、その強度を表す電気信号に変換する。このようにして変換された電気信号は、各検出器761から出力されてそれぞれA/D変換器762にデジタル信号に変換された後、画像処理部763に入力される。画像処理部763は入力されたデジタル信号を画像データに変換する。画像処理部763には、一次電子線を偏向させるための走査信号が供給されるようになっているので、画像処理部はウエハの面を表す画像を表示することになる。この画像を設定器(図示せず)に予め設定された標準パターンと、比較器(図示せず)において比較することによってウエハWの被検出(評価)パターンの良否を検出する。更に、レジストレーションによウエハWの被測定パターンを一次光学系の光軸の近くへ移動させ、ラインスキャンする事によって線幅評価信号を取り出し、これを適宜校正することによって、ウエハの表面に形成されたパターンの線幅を測定することができる。

[0030]

なお、一次光学系のマルチ開口板723の開口を通過した一次電子ビームをウエハWの表面に合焦させ、ウエハから放出される二次電子を検出器761に結像させる際に、一次光学系で生じる歪み、軸上色収差及び視野非点という3つの収差による影響を最小にするよう特に配慮する必要がある。

また、複数の一次電子ビーム間の間隔と、二次光学系との関係については、一次電子ビーム間の間隔を二次光学系の収差よりも大きい距離だけ離せば複数のビーム間のクロストークを無くすことができる。

[0031]

プレチャージュニット 8 1 は、図 1 に示されるように、ワーキングチャンバ 3 1 内で電子光学装置 7 0 の鏡筒 7 1 に隣接して配設されている。本検査装置では検査対象である基板すなわちウエハに電子線を走査して照射することによりウエハ表面に形成されたデバイスパターン等を検査する形式の装置であるから、電子

線の照射により生じる二次電子等の情報をウエハ表面の情報とするが、ウエハ材料、照射電子のエネルギ等の条件によってウエハ表面が帯電(チャージアップ)することがある。更に、ウエハ表面でも強く帯電する箇所、弱い帯電箇所が生じる可能性がある。ウエハ表面の帯電量にむらがあると二次電子情報もむらを生じ、正確な情報を得ることができない。そこで、本実施形態では、このむらを防止するために、荷電粒子照射部811を有するプレチャージユニット81が設けられている。検査するウエハの所定の箇所に検査電子を照射する前に、帯電むらをなくすためにこのプレチャージユニットの荷電粒子照射部811から荷電粒子を照射して帯電のむらを無くす。このウエハ表面のチャージアップは予めウエハ面の画像を形成し、その画像を評価することで検出し、その検出に基づいてプレチャージユニット81を動作させる。

また、このプレチャージユニットでは一次電子線をぼかして照射してもよい。 【0032】

図9において、電位印加機構83は、ウエハから放出される二次電子情報(二次電子発生率)が、ウエハの電位に依存すると言う事実に基づいて、ウエハを載置するステージの設置台に±数Vの電位を印加することにより二次電子の発生を制御するものである。また、この電位印加機構は、照射電子が当初有しているエネルギーを減速し、ウエハに100~500eV程度の照射電子エネルギーとするための用途も果たす。

電位印加機構83は、図9に示されるように、ステージ装置50の載置面54 1と電気的に接続された電圧印加装置831と、チャージアップ調査及び電圧決 定システム(以下調査及び決定システム)832とを備えている。調査及び決定 システム832は、電子光学装置70の検出系76の画像形成部763に電気的 に接続されたモニター833と、モニター833に接続されたオペレータ834 と、オペレータ834に接続されたCPU835とを備えている。CPU835 は、前記電圧印加装置831並びに偏向器727に信号を供給するようになって いる。

上記電位印加機構は、検査対象であるウエハが帯電し難い電位を探し、その電 位を印加するように設計されている。 [0033]

図10において、電子ビームキャリブレーション機構85は、前記回転テーブル上でウエハの載置面541の側部の複数箇所に設置された、ビーム電流測定用のそれぞれ複数のファラデーカップ851及び852を備えている。ファラデーカップ851は細いビーム用(約φ2μm)で、ファラデーカップ852太いビーム用(約φ30μm)である。細いビーム用のファラデーカップ851では回転テーブルをステップ送りすることで、ビームプロフィルを測定し。太いビーム用のファラデーカップ852ではビームの総電流量を計測する。ファラデーカップ851及び852は、上表面が載置面541上に載せられたウエハWの上表面と同じレベルになるように配置されている。このようにして電子銃から放出される一次電子線を常時監視する。これは、電子銃が常時一定の電子線を放出できるわけでなく、使用しているうちにその放出量が変化するためである。

[0034]

アライメント制御装置 8 7 は、ステージ装置 5 0 を用いてウエハWを電子光学装置 7 0 に対して位置決めさせる装置であって、ウエハを光学顕微鏡 8 7 1 を用いた広視野観察による概略合わせ(電子光学系によるよりも倍率が低い測定)、電子光学装置 7 0 の電子光学系を用いた高倍率合わせ、焦点調整、検査領域設定、パターンアライメント等の制御を行うようになっている。このように光学系を用いて低倍率でウエハを検査するのは、ウエハのパターンの検査を自動的に行うためには、電子線を用いた狭視野でウエハのパターンを観察してウエハアライメントを行う時に、電子線によるアライメントマークを容易に検出する必要があるからである。

光学顕微鏡871は、ハウジングに設けられ(ハウジング内で移動可能な設けられていてもよい)ており、光学顕微鏡を動作させるための光源も図示しないがハウジング内に設けられている。また高倍率の観察を行う電子光学系は電子光学装置70の電子光学系(一次光学系72及び二次光学系74)を共用するものである。その構成を概略図示すれば、図11に示されるようになる。ウエハ上の被観察点を低倍率で観察するには、ステージ装置50のXステージ53をX方向に動かすことによってウエハの被観察点を光学顕微鏡の視野内に移動させる。光学

顕微鏡871で広視野でウエハを視認してそのウエハ上の観察すべき位置をCCD872を介してモニタ873に表示させ、観察位置をおおよそ決定する。この場合光学顕微鏡の倍率を低倍率から高倍率に変化させていってもよい。

[0035]

次に、ステージ装置 50 を電子光学装置 70 の光軸と光学顕微鏡 871 の光軸との間隔 δ xに相当する距離だけ移動させて光学顕微鏡で予め決めたウエハ上の被観察点を電子光学装置の視野位置に移動させる。この場合、電子光学装置の軸線 O_3 O_3 と光学顕微鏡 871 の光軸 O_4 O_4 との間の距離(この実施形態ではX軸線に沿った方向にのみ両者は位置ずれしているものとするが、Y軸方向及びY軸方向に位置ずれしていてもよい) δ x は予めわかっているのでその値 δ x だけ移動させれば被観察点を視認位置に移動させることができる。電子光学装置の視認位置への被観察点の移動が完了した後、電子光学系により高倍率で被観察点をSEM撮像して画像を記憶したり、モニタ 765 に表示させる。

このようにして電子光学系による高倍率でウエハの観察点をモニタに表示させた後、公知の方法によりステージ装置50の回転テーブル54の回転中心に関するウエハの回転方向の位置ずれすなわち電子光学系の光軸O3-O3に対するウエハの回転方向のずれるθを検出し、また電子光学装置に関する所定のパターのX軸及びY軸方向の位置ずれを検出する。そしてその検出値並びに別途得られたウエハに設けられた検査マークのデータ或いはウエハのパターンの形状等に関するデータに基づいてステージ装置50の動作を制御してウエハのアライメントを行う。

[0036]

次に図12及び図13を参照して本発明による半導体デバイスの製造方法の実 施例を説明する。

図12は、本発明による半導体デバイスの製造方法の一実施例を示すフローチャートである。この実施例の製造工程は以下の主工程を含んでいる。

- (1) ウエハを製造するウエハ製造工程(又はウエハを準備するウエハ準備工程)
- (2) 露光に使用するマスクを製造するマスク製造工程(又はマスクを準備する

マスク準備工程)

- (3) ウエハに必要な加工処理を行うウエハプロセッシング工程
- (4) ウエハ上に形成されたチップを1個ずつ切り出し、動作可能にならしめる チップ組立工程
- (5) できたチップを検査するチップ検査工程

なお、上記のそれぞれの主工程は更に幾つかのサブ工程からなっている。

[0037]

これらの主工程中の中で、半導体デバイスの性能に決定的な影響を及ぼすのが

- (3)のウエハプロセッシング工程である。この工程では、設計された回路パターンをウエハ上に順次積層し、メモリやMPUとして動作するチップを多数形成する。このウエハプロセッシング工程は以下の各工程を含んでいる。
- (A) 絶縁層となる誘電体薄膜や配線部、或いは電極部を形成する金属薄膜等を 形成する薄膜形成工程(CVDやスパッタリング等を用いる)
- (B) この薄膜層やウエハ基板を酸化する酸化工程
- (C) 薄膜層やウエハ基板等を選択的に加工するためにマスク (レチクル) を用いてレジストパターンを形成するリソグラフィー工程
- (D) レジストパターンに従って薄膜層や基板を加工するエッチング工程 (例えばドライエッチング技術を用いる)
- (E) イオン・不純物注入拡散工程
- (F) レジスト剥離工程
- (G) 加工されたウエハを検査する工程

なお、ウエハプロセッシング工程は必要な層数だけ繰り返し行い、設計通り動作 する半導体デバイスを製造する。

[0038]

図13は、図12のウエハプロセッシング工程の中核をなすリソグラフィー工程を示すフローチャートである。このリソグラフィー工程は以下の各工程を含む

(a) 前段の工程で回路パターンが形成されたウエハ上にレジストをコートする レジスト塗布工程

- (b) レジストを露光する工程
- (c) 露光されたレジストを現像してレジストのパターンを得る現像工程
- (d) 現像されたレジストパターンを安定化するためのアニール工程

上記の半導体デバイス製造工程、ウエハプロセッシング工程、リソグラフィー 工程については、周知のものでありこれ以上の説明を要しないであろう。

上記(G)の検査工程に本発明に係る欠陥検査方法、欠陥検査装置を用いると、微細なパターンを有する半導体デバイスでも、スループット良く検査できるので、全数検査も可能となり、製品の歩留まりの向上、欠陥製品の出荷防止が可能と成る。

[0039]

【発明の効果】

本発明によれば、次のような効果を奏することが可能である。

- (イ)複数の電子線すなわちマルチビームを用いた検査装置の各構成機器を機能 的に組み合わせることができたため、高いスループットで検査対象を処理するこ とができる。
- (ロ) エンバイロメント空間内に清浄度を観察するセンサを設けることによりその空間内の塵埃を監視しながら検査対象の検査を行うことができる。
- (ハ) プレチャージユニットを設けているので、絶縁物でできたウエハも帯電に よる影響を受けがたい。。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明による検査装置の主要構成要素を示す立面図であって、図2の線A-Aに沿って見た図である。

【図2】

図1に示す検査装置の主要構成要素の平面図であって、図1の線B-Bに沿って見た図である。

【図3】

図1のミニエンバイロメント装置を示す断面図であって、線C-Cに沿って見た図である。

【図4】

図1のローダハウジングを示す図であって、図2の線D-Dに沿って見た図である。

【図5】

ウエハラックの拡大図であって、 [A] は側面図で、 [B] は [A] の線E-Eに沿って見た断面図である。

【図6】

主ハウジングの支持方法の変形例を示す図である。

【図7】

図1の検査装置の電子光学装置の概略構成を示す模式図である。

【図8】

図7の電子光学装置の一次光学系に使用されているマルチ開口板の開口の位置関係を示す図である。

【図9】

電位印加機構を示す図である。

【図10】

電子ビームキャリブレーション機構を説明する図であって、 [A] は側面図であり、 [B] は平面図である。

【図11】

ウエハのアライメント制御装置の概略説明図である。

【図12】

本発明による半導体デバイスの製造方法の一実施例を示すフローチャートである。

【図13】

図11のウエハプロセッシング工程の中核をなすリソグラフィー工程を示すフローチャートである。

【符号の説明】

- 1 検査装置
- 10 カセットホルダ

- 20 ミニエンバイロメント装置
 - 21 ミニエンバイロメント空間
- 22 ハウジング

23 気体循環装置

24 排出装置

25 プリアライナー

26、27 シャッタ装置

- 30 主ハウジング
 - 31 ワーキングチャンバ
- 32 ハウジング本体
- 33 ハウジング支持装置
- 36 台フレーム

- 37 防振装置
- 40 ローダハウジング
 - 41、42 ローディングチャンバ 43 ハウジング本体
 - 45、46 シャッタ装置
- 47 ウエハラック

- 50 ステージ装置
- 51 固定テーブル

52 Yテーブル

53 Xテーブル

54 回転テーブル

- 60 ローダー
- 61、62 搬送ユニット
- 70 電子光学装置
 - 71 鏡筒

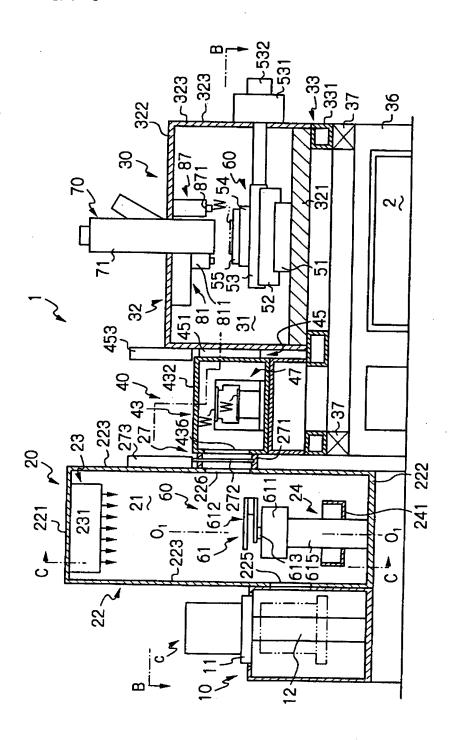
72 一次電子光学系

74 二次電子光学系

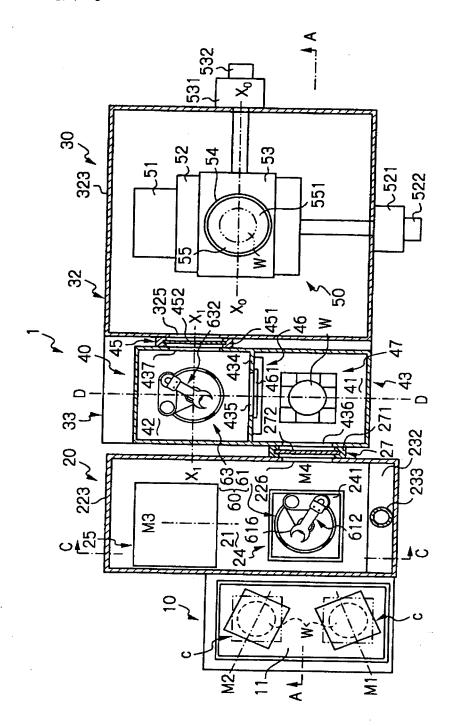
- 76 検出系
- 81 プレチャージユニット
- 83 電位印加機構

- 87 アライメント制御装置
- 85 電子ビームキャリブレーション機構

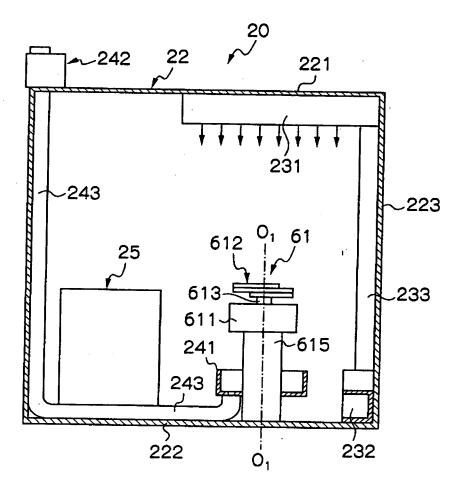
【書類名】 図面 【図1】



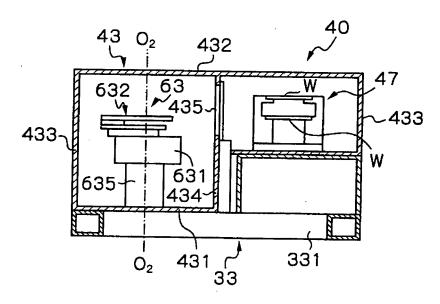
【図2】



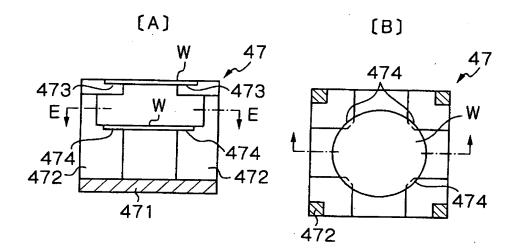
【図3】



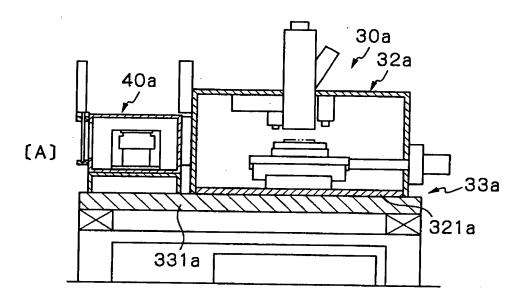
【図4】

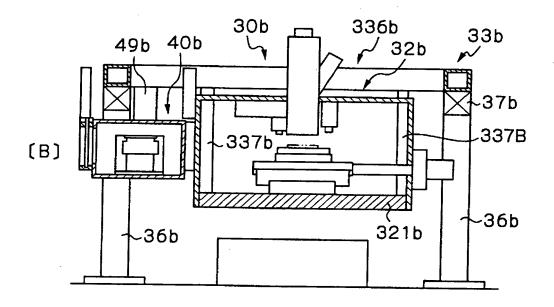


【図5】

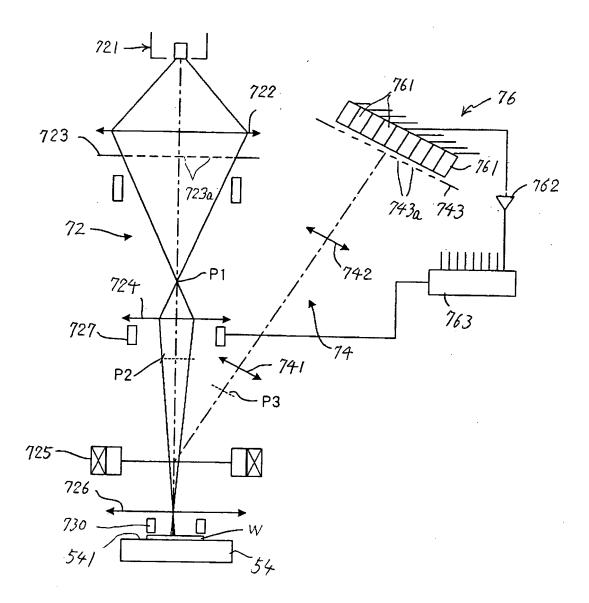


【図6】

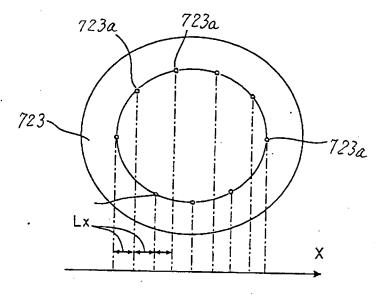




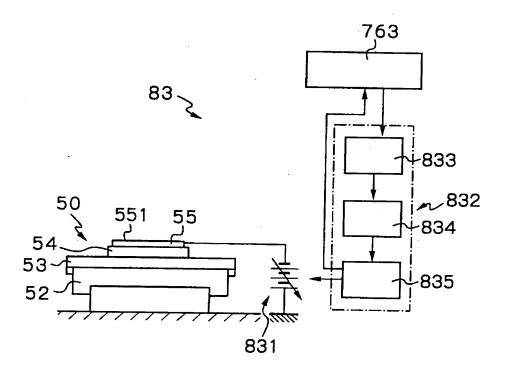
【図7】



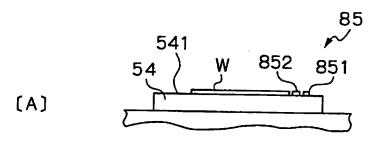
【図8】

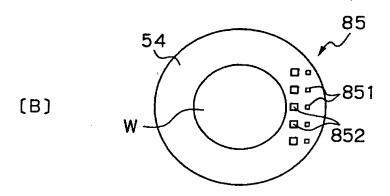


【図9】

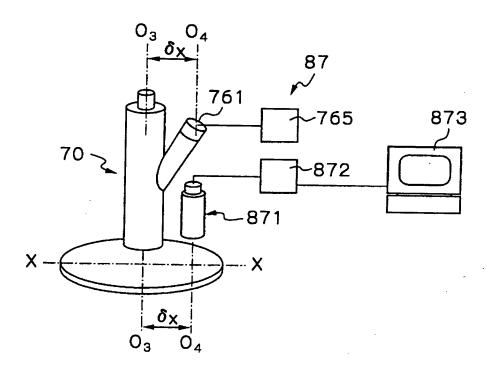


【図10】

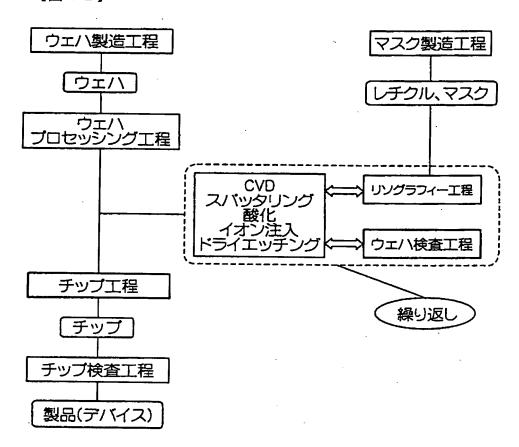




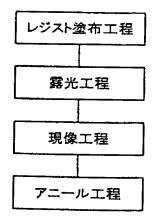
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】 電子線でパターンが形成された検査対象を照射し、前記検査対象の欠陥を検査する装置1は、複数の一次電子線を成形して前記検査対象に照射し、一次電子線の照射により放出された二次電子を投影する電子光学系と、電子光学系により投影された二次電子像を検出する複数の検出器と、検査対象を保持し移動させるステージ装置50と、ステージ装置を収容しているワーキングチャンバ31と、ワーキングチャンバ内の前記ステージ装置上に検査対象を供給するローダー60と、ワーキングチャンバ内には検査対象に電位を印加する電位印加機構と、検査対象の表面を観察してアライメントの制御を行う装置と、を備え、ワーキングチャンバは床からの振動を遮断する振動遮断装置を介して支持されている。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000004112]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

氏 名 株式会社ニコン

出願人履歷情報

識別番号

[000000239]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区羽田旭町11番1号

氏 名 株式会社荏原製作所